

# ARF463A(G) ARF463B(G)

\*G Denotes RoHS Compliant. Pb Free Terminal Finish.

Common  
Source

## RF POWER MOSFETS N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE

**125V 100W 100MHz**

The ARF463A and ARF463B comprise a symmetric pair of common source RF power transistors designed for push-pull scientific, commercial, medical and industrial RF power amplifier applications up to 100 MHz. They have been optimized for both linear and high efficiency classes of operation.

- Specified 125 Volt, 81.36 MHz Characteristics:**
- Low Cost Common Source RF Package.**
- Output Power = 100 Watts.**
- Low  $V_{th}$  thermal coefficient.**
- Gain = 15dB (Class AB)**
- Low Thermal Resistance.**
- Efficiency = 75% (Class C)**
- Optimized SOA for Superior Ruggedness.**

### MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	ARF463A/B(G)	UNIT
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	500	Volts
$I_D$	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	9	Amps
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage	$\pm 30$	Volts
$P_D$	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	180	Watts
$R_{\theta JC}$	Junction to Case	0.70	$^\circ\text{C/W}$
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	

### STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage ( $V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$ )	500			Volts
$V_{DS(ON)}$	On State Drain Voltage <sup>①</sup> ( $I_D(ON) = 4.5A, V_{GS} = 10V$ )			5.0	
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$ )			25	$\mu\text{A}$
	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$ )			250	
$I_{GSS}$	Gate-Source Leakage Current ( $V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$ )			$\pm 100$	nA
$g_{fs}$	Forward Transconductance ( $V_{DS} = 25V, I_D = 4.5A$ )	4	6		mhos
$V_{GS(TH)}$	Gate Threshold Voltage ( $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 50mA$ )	3		5	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

ARF463A/B(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 50V$ $f = 1\text{ MHz}$		1200	1600	pF
$C_{oss}$	Output Capacitance			140	200	
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance			9	12	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$ $R_G = 1.6\Omega$		5.1	10	ns
$t_r$	Rise Time			4.1	8	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			12.8	20	
$t_f$	Fall Time			4	8	

## FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$G_{PS}$	Common Source Amplifier Power Gain	$f = 81.36\text{ MHz}$	13	15		dB
$\eta$	Drain Efficiency	$I_{dq} = 50\text{mA}$ $V_{DD} = 125V$	60	65		%
$\Psi$	Electrical Ruggedness VSWR 10:1	$P_{out} = 100W$	No Degradation in Output Power			

① Pulse Test: Pulse width < 380  $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

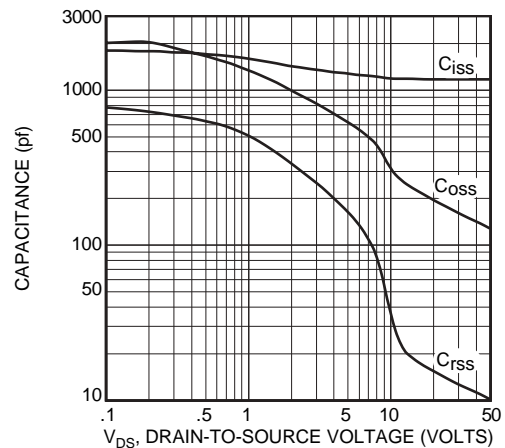


Figure 2, Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage

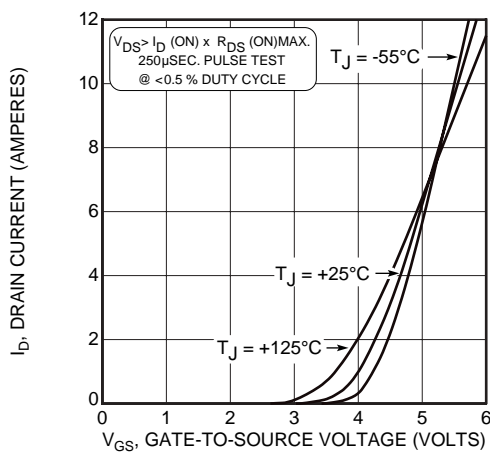


Figure 3, Typical Transfer Characteristics

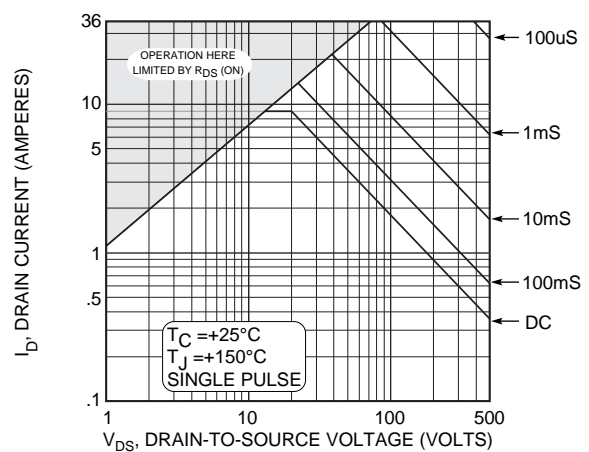


Figure 4, Typical Maximum Safe Operating Area

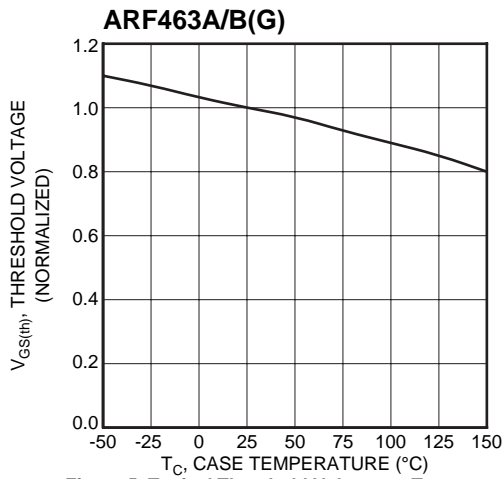


Figure 5, Typical Threshold Voltage vs Temperature

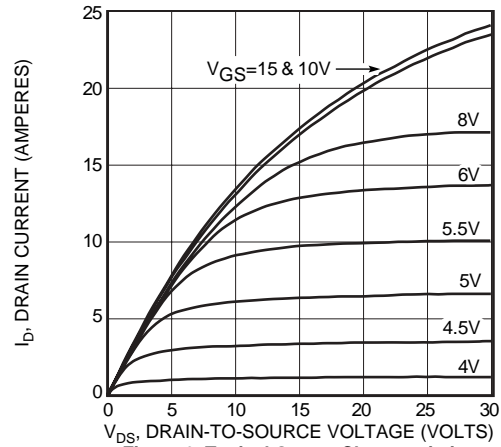


Figure 6, Typical Output Characteristics

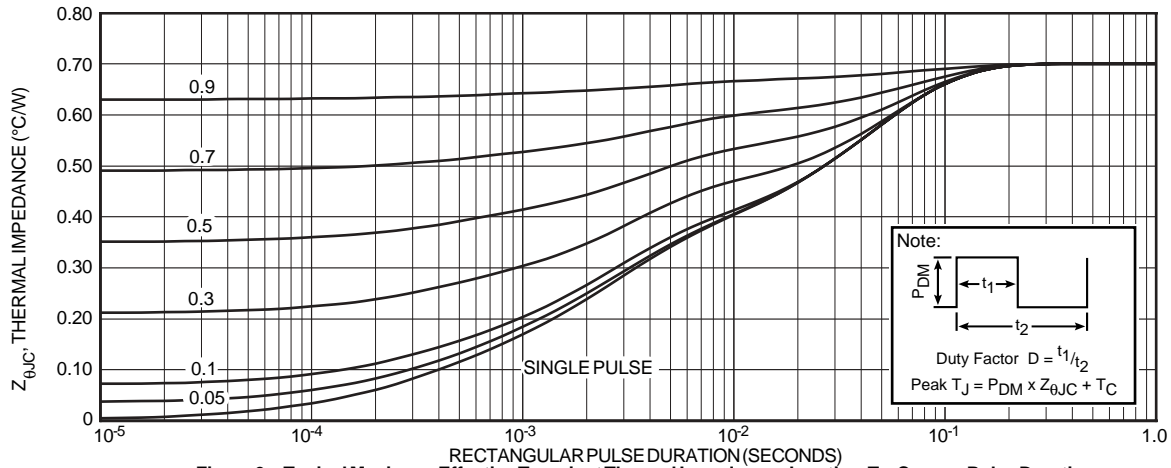


Figure 9a, Typical Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-To-Case vs Pulse Duration

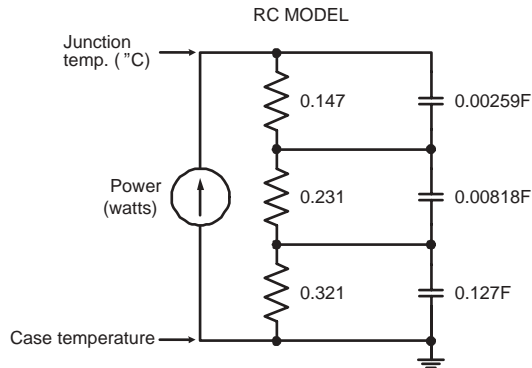
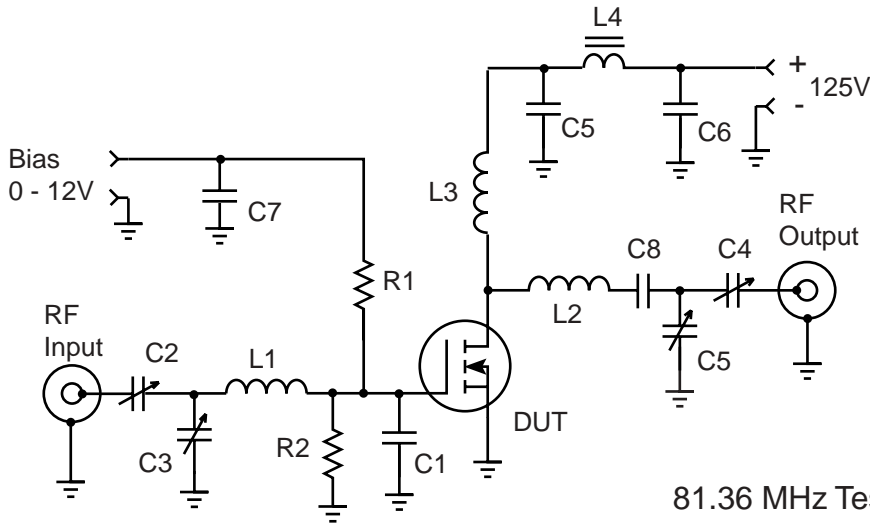


Figure 9b, TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

Table 1 - Typical Class AB Large Signal Input - Output Impedance

Freq. (MHz)	Z <sub>in</sub> (Ω)	Z <sub>OL</sub> (Ω)
2.0	24 - j 5.0	55 - j 4.8
13.5	7.8 - j 11	41 - j 24
27	2.1 - j 6.4	23 - j 26.2
40	.74 - j 3.3	13.6 - j 22
65	.30 + j .42	6.1 - j 14.2
80	.46 + j 2.0	4.2 - j 10.7
100	.87 + j 3.7	2.7 - j 7.1

Z<sub>in</sub> - Gate shunted with 25Ω □ □ I<sub>DQ</sub> = 50mA  
 Z<sub>OL</sub> - Conjugate of optimum load for 100 Watts output at V<sub>DD</sub> = 125V

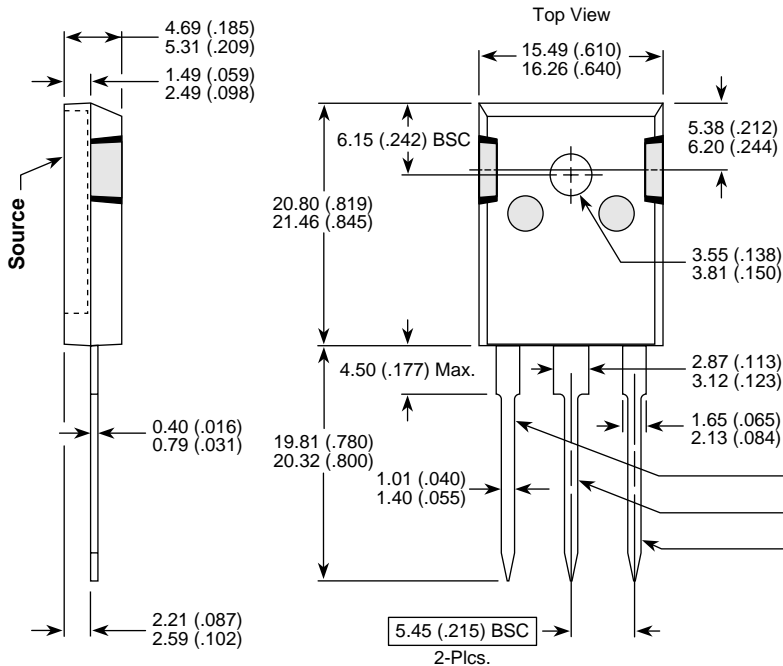


- C1 -- 820pF Unelco mounted at gate lead
- C2-C5 -- Arco 463 Mica trimmer
- C5-C8 -- 10nF 500V COG chip
- L1 -- 3t #18 .3" ID .25"L ~50nH
- L2 -- 3t #16 AWG .25" ID .3"L ~58nH
- L3 -- 10t #18 AWG .25 ID ~470nH
- L4 -- VK200-4B ferrite choke ~3uH
- R1-R2 -- 50 Ohm 1/2W Carbon
- DUT = ARF463A/B

81.36 MHz Test Circuit

**TO-247 Package Outline**

e3 100% Sn Plated



**HAZARDOUS MATERIAL WARNING**

The ceramic portion of the device between leads and mounting surface is beryllium oxide, BeO. Beryllium oxide dust is toxic when inhaled. Care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area. These devices must never be thrown away with general industrial or domestic waste.

Dimensions in Millimeters and (Inches)

**NOTE:** These two parts comprise a symmetric pair of RF power transistors and meet the same electrical specifications. The device pin-outs are the mirror image of each other to allow ease of use as a push-pull pair.

Device	
ARF - A	ARF - B
Gate	Drain
Source	Source
Drain	Gate

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)